



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» (АО «НИИПП»)

✉ Россия, 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а, ИНН\КПП 7017084932\701701001
☎ (382-2) 288-288 (приемная), факс (382-2) 55-50-89.
E-mail: niipp@niipp.ru www.niipp.ru

Исх. № 9195 от 24.12. 2018 г.

На № _____ от _____ 2018 г.

Председателю диссертационного совета
212.268.04 на базе Томского
государственного университета систем
управления и радиоэлектроники, д.т.н.,
профессору Шандарову С.М.

О согласии выступить ведущей
организацией

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40

Уважаемый Станислав Михайлович!

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» подтверждает согласие выступить ведущей организацией по диссертационной работе Сима Павла Евгеньевича «Исследование омических контактов НЕМТ транзисторов на основе GaN» по специальности 01.04.04 – «физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Необходимые сведения прилагаются.

Приложение: сведения о ведущей организации на 2-х листах в 1 экз.

С уважением,

Директор по научной работе

Е.А. Монастырев

26.12.2018

Сведения о ведущей организации

по диссертации Сима Павла Евгеньевича «Исследование омических контактов НЕМТ транзисторов на основе GaN» по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	АО «НИИПП»
Почтовый индекс, адрес организации	634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а
Веб-сайт	http://www.niipp.ru/
Телефон	(3822) 288-288
Адрес электронной почты	niipp@niipp.ru
Список основных публикаций работников структурного подразделения, в котором будет готовиться отзыв, по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1) Ющенко А.Ю., Айзенштат Г.И., Монастырев Е.А., Божков В.Г., Иващенко А.И., Безрук А.В. Результаты ОАО «НИИПП» в области разработки GaAs СВЧ МИС на основе pin-диодов / Электронная промышленность. 2014. № 1. С. 65-75.</p> <p>2) G. I. Ayzenshtat, V. G. Bozhkov, A. Yu. Yushchenko Transient Processes in The GaAs-Based Microwave-PIN-Diodes/ Russian Physics Journal, Vol. 57, No. 12, 2015, pp. 1627-1633.</p> <p>3) G.I. Ayzenshtat, A. Yu. Yushchenko A Metod for Determining the Ambipolar Diffusion Length and Carrier Lifetime in GaAs p-i-n Diodes/ Instruments and Experimental Techniques. 2015, Vol.58. No2, pp.118-121.</p> <p>4) Ющенко А.Ю., Айзенштат Г.И., Пласкеев А.А., Безрук А.В., Иващенко А.И., Фролова У.М., Федотова Ф.И. Контактное устройство для зондовых измерений СВЧ нитридгаллиевых усилителей в импульсном режиме/ Электронная техника, сер.1, СВЧ-техника, вып.1 (534), 2015, с. 40–46.</p> <p>5) Емельянов Е.В., Ющенко А.Ю., Божков В.Г., Геннеберг В.А., Усюкевич А.А. Принципы построения твердотельного генератора шума 2-миллиметрового</p>

диапазона длин волн/ Известия высших учебных заведений. Физика. 2017. №12-2, С. 47-50.

6) Юценко А.Ю., Айзенштат Г.И., Федотова Ф.И. Диоды Шоттки на гетероструктурах с двумерным электронным газом/ Известия высших учебных заведений. Физика. 2018. Т. 61. №12. С.14-20.

7) Vladislav V. Rostov¹, Eugene M. Totmeninov¹, Ruslan V. Tsygankov¹, Ivan K. Kurkan¹, Oleg B. Kovalchuk¹, Anton A. Elchaninov¹, Alexei S. Stepchenko¹, Alexander V. Gunin¹, Vladimir Y. Konev^{1,2}, Alexei Y. Yushchenko², and Eugene V. Emelyanov² Two-wave Ka-band nanosecond relativistic Cherenkov oscillator/ IEEE Transactions on electron devices. Volume: 65, Issue 7, 2018, p. 3019-3025.

8) V. V. Rostov¹, I. V. Romanchenko¹, R. V. Tsygankov¹, A. Y. Yushchenko², E. V. Emelyanov², A. G. Sadykova³, K. A. Sharypov³, S. A. Shunailov³, M. R. Ul'masculov³, and M. I. Yalandin³ Numerical and experimental investigation of 4 mm wavelength microwave oscillator based on high-current compact accelerator/ Physics of Plasmas. Volume: 25, Issue 7, 2018.

¹ Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, Россия

² АО «НИИПП», г. Томск, Россия

³ Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Верно

Секретарь НТС,
начальник НТО АО «НИИПП»



А.В. Васильев

«26» 12 2018 г.